

MURD2020CT

Rev.F May.-2016

描述 / Descriptions

TO-252 塑封封装 超快恢复二极管。

Ultrafast Recovery Diode in a TO-252 Plastic Package.

特征 / Features

采用硅外延工艺生产的超快恢复二极管，具有较低的反向漏电流和高可靠性。

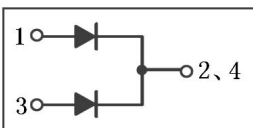
Silicon epitaxial process to produce ultrafast recovery diode with low reverse leakage current and high reliability.

用途 / Applications

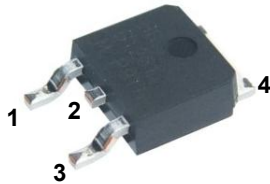
用于高频、高压、大电流整流二极管，续流二极管。

For high frequency, high voltage, high current rectifier diode, freewheeling diode.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Anode

PIN 2、4 : Cathode

PIN 3 : Anode

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	200	V
RMS Reverse Voltage	V_{RMS}	140	V
DC Blocking Voltage	V_{DC}	200	V
Average Forward Current	I_F	2×10	A
Non Repetitive Peak Surge Current	I_{FSM}	120	A
Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	2.8	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-55~150	°C

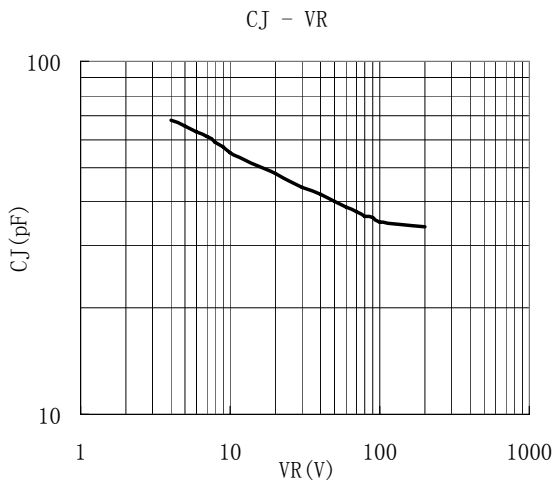
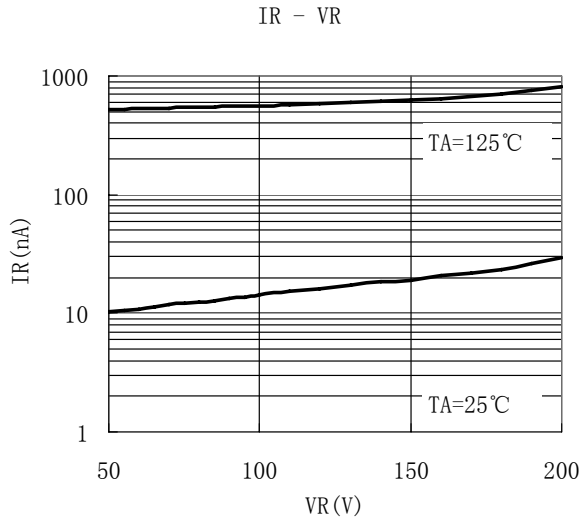
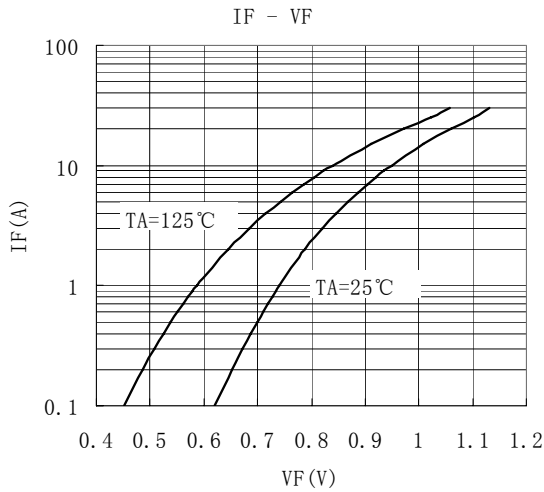
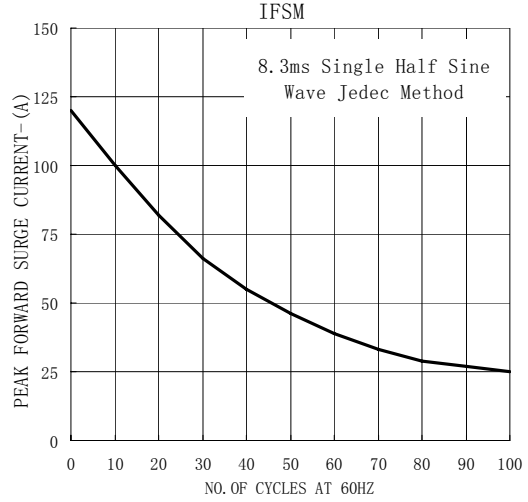
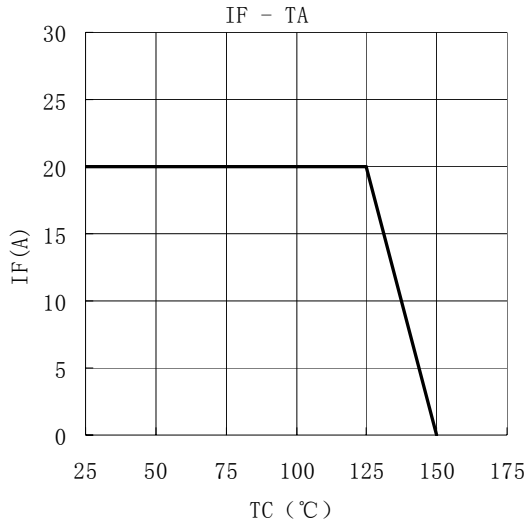
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Forward Voltage	V_F	$I_F=2A$ $T_c=25^\circ C$		0.79		V
		$I_F=2A$ $T_c=125^\circ C$		0.65		V
		$I_F=10A$ $T_c=25^\circ C$		0.95	1.0	V
		$I_F=10A$ $T_c=125^\circ C$		0.84	0.9	V
Instantaneous Reverse Current	I_R (Note 1)	$V_R=200V$ $T_a=25^\circ C$			10	μA
		$V_R=200V$ $T_a=125^\circ C$			150	μA
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=0.5A$ $I_R=1.0A$ $I_{RR}=0.25A$			35	ns

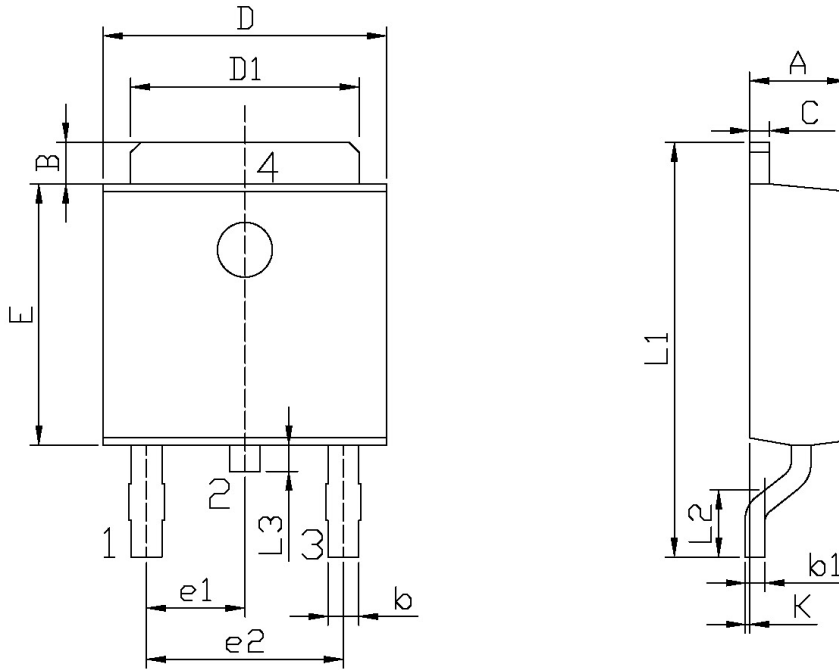
注/Notes:

1. 使用极短的测试时间,以尽量减少自热效应。/Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
2. 除非特别注明,数值为一个芯片的参数。/ Unless otherwise noted, values for the parameters of a single chip

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions



单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	E	5.95	6.25
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.50	0.70	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L1	9.45	9.95
C	0.45	0.55	L2	1.25	1.75
D	6.45	6.75	L3	0.60	0.90
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

TO-252

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

MURD2020： 为产品型号

CT: 为内部结构

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

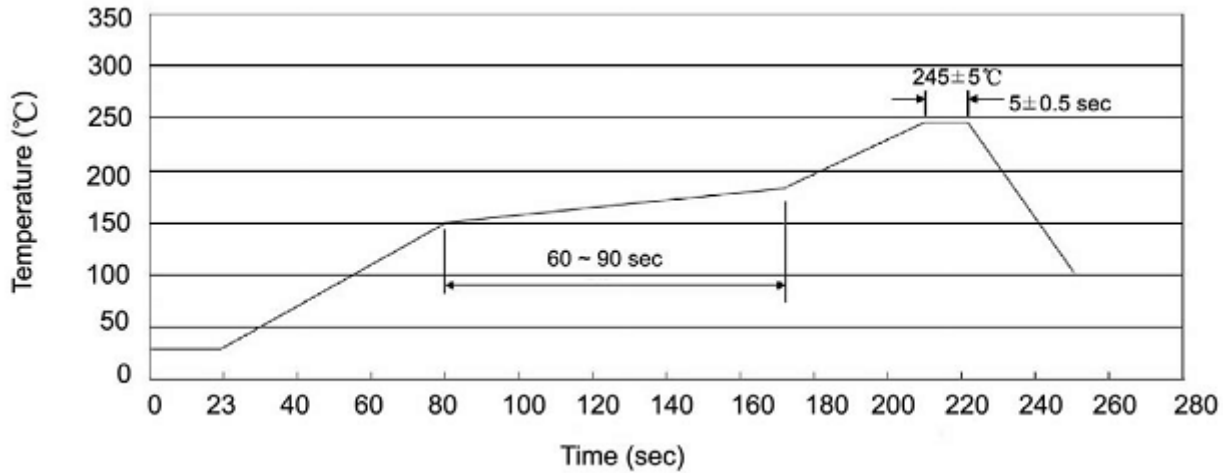
BR: Company Code

MURD2020： Product Type.

CT: Internal Structure

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C 时间：10±1 sec. Temp.:260±5°C Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	5	25,000	13" ×16	360×360×50	385×257×392

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices